

Silicon PIN Diode

BA389

30V / 50mA

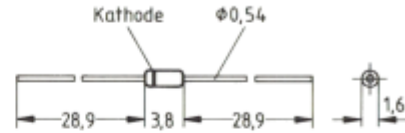
DATASHEET

OEM – Siemens

Source: Siemens Databook 1986/87

Silizium-PIN-Diode**BA 389****Vorläufige Daten****DO 35 DHD**

- Stromgesteuerter HF-Widerstand für Schalt- und Regelanwendung
- Nutzbarer Frequenzbereich
1 MHz ... 1 GHz



Typ	BA 389
Best.-Nr.	Q62702-A732
Farbe	gelb

Grenzdaten

Sperrspannung	V_R	30	V
Durchlaßstrom	I_F	50	mA
Sperrschichttemperatur	T_J	150	°C
Lagertemperatur	T_{stg}	-65... +150	°C

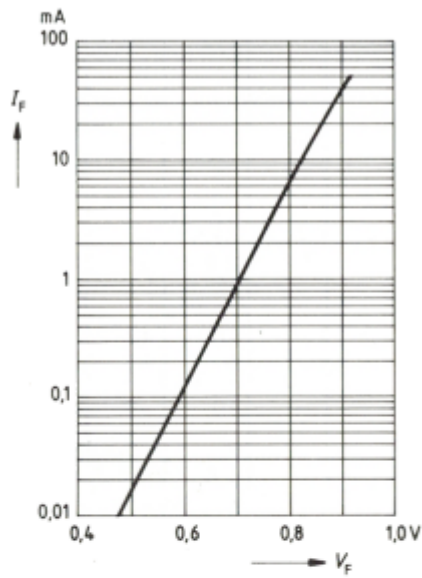
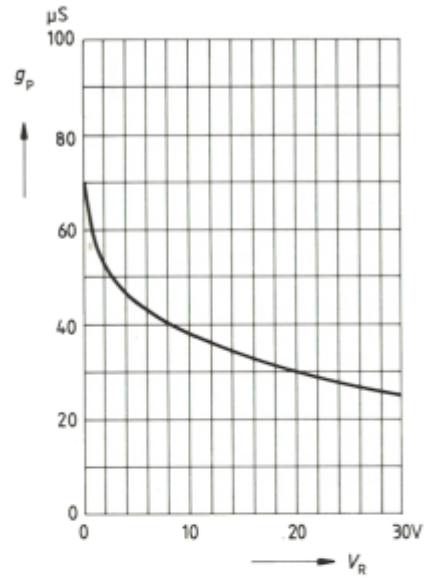
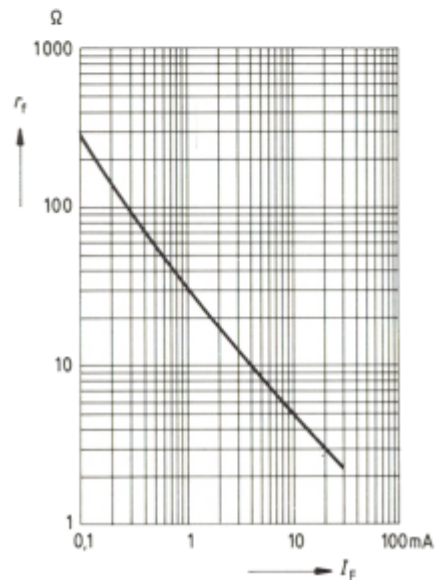
Wärmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung	$R_{th,JA}$	≤ 400	K/W
-----------------------	-------------	-------	-----

BA 389**Kenndaten** ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

		min	typ	max	
Durchlaßspannung $I_F = 50\text{ mA}$	V_F	—	—	1	V
Sperrstrom $V_R = 30\text{ V}$	I_R	—	—	50	nA
Diodenkapazität $V_R = 10\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$ $0\text{ V}, 100\text{ MHz}$	C_T	—	0,55	—	pF
		—	0,35	0,5	pF
Flußwiderstand, $f = 100\text{ MHz}$ $I_F = 1,5\text{ mA}$ 10 mA	r_t	—	25	40	Ω
		—	5	7,5	Ω
Sperrleitwert $V_R = 0\text{ V}, f = 100\text{ MHz}$	g_p	—	70	—	μS
Serieninduktivität	L_s	—	2,5	—	nH

BA 389

Durchlaßkennlinie $I_F = f(V_F)$ Sperrleitwert $g_p = f(V_R)$ Durchlaßwiderstand $r_f = f(I_F)$
 $f = 100 \text{ MHz}$ Diodenkapazität $C_T = f(V_R)$ 